








	<p>SI8823EDB-T2-E1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8823EDB-T2-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 2.7A 4-MICROFOOT</p> <p>Datenblätter:  SI8823EDB-T2-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8823EDB-T2-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.7A 4-MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-MICRO FOOT® (0.8x0.8)
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	95 mOhm @ 1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	900mW (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	580pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Tc)

SI8823EDB-T2-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8823EDB-T2-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8823EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8823EDB-T2-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI88222BC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI88221EC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI88240BC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88222EC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>
 <p>SI88240BC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88240EC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC</p>	 <p>SI88222EC-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI88222BC-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8823EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix	SI8823EDB-T2-E1 Datenblatt	SI8823EDB-T2-E1-Datenblätter	SI8823EDB-T2-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8823EDB-T2-E1
SI8823EDB-T2-E1 Electronic	SI8823EDB-T2-E1-Komponenten	SI8823EDB-T2-E1-Verteiler	SI8823EDB-T2-E1-Bild	SI8823EDB-T2-E1-Teil
SI8823EDB-T2-E1 Preis	SI8823EDB-T2-E1 Hersteller	SI8823EDB-T2-E1 Bild	SI8823EDB-T2-E1 Aktie	SI8823EDB-T2-E1 Inventar
SI8823EDB-T2-E1 Neu	SI8823EDB-T2-E1 Original	SI8823EDB-T2-E1 garantiert	SI8823EDB-T2-E1 RFQ	SI8823EDB-T2-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited